



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於無錫市好達電子股份有限公司  
首次公開發行股票並在科创板上市的  
補充法律意見書（三）

二〇二一年十一月

## 目录

一、问题 2.....	5
-------------	---



北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔23-31层，邮编：100020  
23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于无锡市好达电子股份有限公司

### 首次公开发行股票并在科创板上市的

### 补充法律意见书（三）

致：无锡市好达电子股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）事宜的专项法律顾问。本所已于2021年6月28日出具《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）和《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市出具法律意见书的律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”）等文件。

鉴于发行人于2021年7月22日收到上交所出具的《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2021]444号，以下简称“《问询函》”），以及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2021年1月1日至2021年6月30日（简称“补充核查期间”）的经营成果及财务状况进行了补充审计并于2021年8月31日出具了报告期更新至2021年6月30日的《无锡市好达电子股份有限公司审计报告及财务报表》（苏公W[2021]A1326号，以下简称“《审计报告》”）、《无锡市好达电子股份有限公司内部控制鉴证报告》（苏公W[2021]A1326号，以下简称“《内部控

制鉴证报告”），本所律师对《问询函》中的相关法律问题进行回复并对发行人报告期更新后发行人本次发行及上市相关情况补充查证，出具《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》（以下简称《补充法律意见书（一）》）。

鉴于发行人于2021年9月30日收到上交所出具的《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2021]620号，以下简称“《第二轮问询函》”），本所律师对《第二轮问询函》中的相关法律问题进行回复，出具《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（二）》（以下简称《补充法律意见书（二）》）。

鉴于发行人于2021年11月12日收到上交所出具的《关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）[2021]687号，以下简称“《落实函》”），本所律师对《落实函》中的相关法律问题进行回复，出具《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的补充法律意见书（三）》（以下简称《补充法律意见书（三）》）。

本补充法律意见书与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》《律师工作报告》是不可分割的一部分。在本补充法律意见书中未发表意见的事项，则以《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》为准；本补充法律意见书中所发表的意见与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》有差异的，或者《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》未披露或未发表意见的，则以本补充法律意见书为准。本补充法律意见书声明事项，除本补充法律意见书另有说明外，与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》所列声明事项一致，在此不再赘述。

除另有说明外，本补充法律意见书所用简称与《法律意见书》《补充法律意见书（一）》《补充法律意见书（二）》和《律师工作报告》所使用简称一致。

本所根据《公司法》《证券法》《科创板首发办法》等有关法律、法规和规

范性文件的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具补充法律意见如下:

## 一、问题 2

请发行人结合与村田的专利纠纷中公司涉诉产品的研发过程，进一步说明相关技术来源的合法合规性，发行人涉诉产品是否存在侵犯村田知识产权的情形。

请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

回复：

### （一）核查方式、过程

为核查上述问题，本所律师履行了包括但不限于如下核查程序：

（1）访谈发行人研发总监，了解发行人 5 款涉诉产品的研发过程、声表面波射频芯片的核心研发技术流程以及村田所称涉案专利所涉技术与发行人研发技术流程的对应关系；

（2）访谈 5 款涉诉产品的研发人员，查阅相关阶段性成果文件；

（3）查阅发行人与村田诉讼案件的相关材料（包括但不限于起诉状、裁定书、上诉状等）；

（4）查阅外部机构出具的相关意见；

（5）查阅发行人出具的说明。

### （二）核查结果

1、结合与村田的专利纠纷中公司涉诉产品的研发过程，进一步说明相关技术来源的合法合规性

#### （1）发行人涉诉产品的研发过程

根据发行人出具的说明，发行人涉诉产品的研发过程与其他声表面波射频芯片（滤波器、双工器、谐振器）的研发过程基本一致，在量产前主要会经过芯片仿真设计、样品试制等研发过程。发行人产品主要研发过程及所需研发技术流程、对应的具体研发部门和阶段性成果文件的具体情况如下：

主要研发过程	所需研发技术流程	所需技术的具体内容	具体执行的研发部门	阶段性成果文件
芯片仿真设计	基板设计	运用商用软件，对芯片和外部电学连接的结构与电路部分进行设计	射频电路组	版图文件
	电磁设计	运用商用软件，对滤波器布图、电路互联、封装结构等整体电磁环境进行设计与仿真	产品开发组	HFSS 文件
	滤波器设计	运用自研仿真设计平台，对滤波器核心部件 IDT（叉指换能器）的膜厚、孔径和周期等相关参数进行仿真设计，该步骤能够很大程度上决定滤波器在插入损耗、带外抑制等关键性能指标上的表现	产品开发组	S 参数文件
	其他设计	对散热、连接结构等热学、力学部分进行设计	产品开发组	HFSS 文件
	实验迭代	结合发行人在样品试制时反馈的实验参数，修正仿真与设计平台的内置常量	产品开发组	性能测试图
样品试制	芯片制造*	优化生产工艺以满足具体滤波器的量产要求	工艺开发组	产品规格书
	封装测试*			

注：\*表示声表面波射频芯片的核心研发技术流程，该等流程的技术水平能够代表不同厂商的核心技术能力。

由上表可知，发行人每款声表面波射频芯片（滤波器、双工器、谐振器）的主要研发过程及所需技术的开发均对应具体执行的研发部门，并在各阶段留存有相应的成果文件。

经访谈 5 款涉诉产品的主要研发人员并核查对应的阶段性成果文件，发行人 5 款涉诉产品相应的研发人员具体情况如下：

主要研发过程	所需研发技术流程	主要研发人员				
		HDFB01R SS-B5	HDDB05A NSS-B11	HDFB07R SS-B5	HDFB08A RSS-B5	HDFB40R SB-B5
芯片仿真设计	滤波器设计	徐彬、王绍安	徐彬、王绍安	徐彬、韦鹏	徐彬、韦鹏	徐彬、王绍安
	实验迭代	王绍安	王绍安	韦鹏	韦鹏	王绍安
样品试制	芯片制造	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻	袁蔚旻
	封装测试	梅从祥	梅从祥	梅从祥	梅从祥	梅从祥

（2）涉案专利所涉技术均不属于发行人的核心研发技术流程，发行人涉诉产品相关技术均为行业通用技术或基于行业公知技术进行二次创新形成

根据发行人出具的说明，村田所称涉案专利与发行人研发技术流程的对应关系如下：

研发主要过程	所需研发技术流程		涉案专利所涉技术与发行人研发技术流程的对应关系				
			HDFB01RSS-B5	HDDB05ANSS-B11	HDFB07RSS-B5	HDFB08ARSS-B5	HDFB40RSB-B5
芯片仿真设计	滤波器设计	基板设计	-	-	-	-	-
		电磁设计	ZL200410005583.3	-	ZL200410005583.3; ZL200410075163.2	ZL200410005583.3	ZL200410005583.3
		IDT设计*	-	-	-	-	-
		其他设计	-	ZL201280047249.7	-	-	-
	实验迭代	-	-	-	-	-	
样品试制	芯片制造*		-	-	-	-	-
	封装测试*		-	-	-	-	-

注：\*表示声表面波射频芯片的核心研发技术流程，该等流程的技术水平能够代表不同厂商的核心技术能力。

根据发行人出具的说明，发行人 5 款涉诉产品对应的 3 项涉案专利分别归属于发行人滤波器设计中的电磁设计和其他设计这 2 个研发技术流程，均不属于发行人的核心研发技术流程。

根据发行人出具的说明，研发过程中的非核心研发技术流程与滤波器关键性能指标表现的关联度较弱，相关技术难度不高且存在较多的行业通用技术。发行人 5 款涉诉产品的相关技术均为行业公知技术或基于行业公知技术进行二次创新形成，具体情况如下：

涉案专利	涉诉产品型号	发行人使用的相关技术	相关技术性质
ZL200410005583.3	HDFB07RSS-B5、 HDFB40RSB-B5、 HDFB01RSS-B5、 HDFB08ARSS-B5	交叉金属走线间绝缘膜技术	行业通用技术
ZL200410075163.2	HDFB07RSS-B5	增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术	基于行业公知技术进行二次创新形成
ZL201280047249.7	HDDB05ANSS-B11	高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术	行业通用技术

1) 交叉金属走线间绝缘膜技术

经访谈研发总监并经发行人说明，交叉金属走线间绝缘膜技术属于行业通用技术，是一种在各个领域广泛使用的技术常识，也是微电子器件领域内近几十年来一直在用的公知技术。

## 2) 增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术

经访谈研发总监并经发行人说明，增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术系发行人基于公知技术进行二次创新形成。

## 3) 高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术

经访谈研发总监并经发行人说明，高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术属于行业通用技术。

综上，结合涉诉产品的主要研发过程，发行人涉案专利所涉技术均不属于发行人的核心研发技术流程，均为行业通用技术或基于行业公知技术进行二次创新形成，相关技术来源合法合规。

## 2、发行人涉诉产品是否存在侵犯村田知识产权的情形

根据上述关于涉诉产品研发过程以及相关技术来源均合法合规的相关论述，并结合外部机构等出具的相关意见，发行人产品是否侵犯村田知识产权的情形具体如下：

### (1) 关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL200410005583.3 号专利

发行人已申请豁免披露。

### (2) 关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL200410075163.2 号专利

发行人已申请豁免披露。

### (3) 关于发行人涉诉产品是否侵犯村田 ZL201280047249.7 号专利

发行人已申请豁免披露。

## (三) 核查意见

经核查，本所律师认为：

结合发行人涉诉产品的研发过程，发行人涉诉产品的相关技术来源合法合规；根据外部机构出具的相关意见，发行人涉诉产品未落入村田涉案专利 ZL200410005583.3、和 ZL201280047249.7 的保护范围，未侵犯其知识产权；因发行人与村田的诉讼案件尚在审理中，发行人涉诉产品是否侵犯村田涉案专利最终有待人民法院审理判决。

（以下为本补充法律意见书（三）的签署页，无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于无锡市好达电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市补充法律意见书（三）》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人 张学兵

张学兵

经办律师

陈益文  
陈益文

经办律师

葛永彬  
葛永彬

2021年11月18日